



$V_{DS} = -30V$

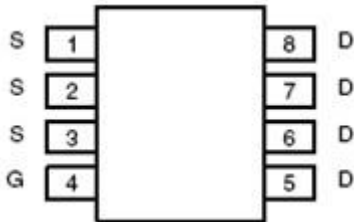
$R_{DS(ON)}, V_{GS}@-10V, I_{DS}@-7A = 12m\Omega@TYP$

$R_{DS(ON)}, V_{GS}@-4.5V, I_{DS}@-5A = 17m\Omega@TYP$

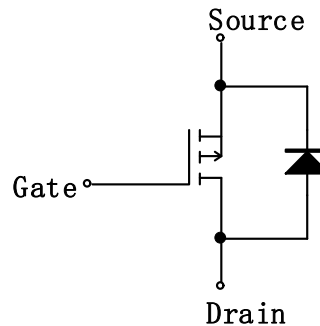
### 特点

- 高级的加工技术
- 极低的导通电阻高密度的单元设计
- 改良的成型工艺

### 封装图: SOP-8



### 内部结构示意图



**P-Channel MOSFET**

### 最大额定值和热特性 (TA=25°C, 除非另有说明。)

参数	符号	值	单位
漏源电压	$V_{DS}$	-30	V
栅源电压	$V_{GS}$	±20	
漏极电流	$I_D$	-8	A
漏极脉冲电流	$I_{DM}$	-30	
工作结温和存储温度范围	$T_J, T_{stg}$	-55 to 150	°C

注: 重复性极限值: 脉冲宽度由最高结温限制。



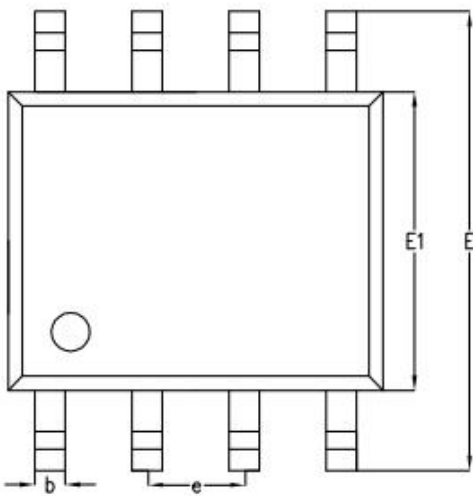
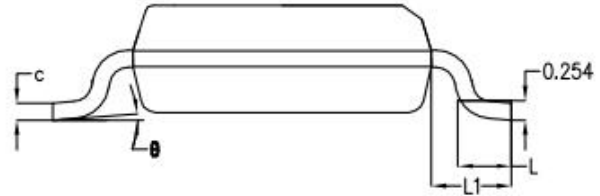
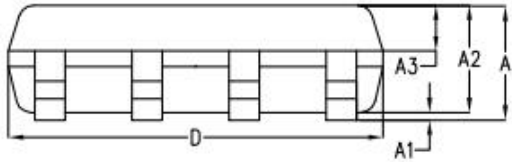
#### 电特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS} = 0V, I_D = -250\mu A$	-30.0	--	--	V
漏源电阻	$R_{DS(on)}^{\text{注}1}$	$V_{GS} = -4.5V, I_D = -6A$	--	17.0	25.0	mΩ
	$R_{DS(on)}^{\text{注}1}$	$V_{GS} = -10V, I_D = -12A$	--	12.0	15.0	
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu A$	-1.0	--	-2.5	V
栅源短路时漏极电流	$I_{DSS}$	$V_{DS} = -30V, V_{GS} = 0V$	--	--	-990	nA
漏极短路时截止栅电流	$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 25V, I_{DS} = 0V$	--	--	$\pm 100$	nA
栅极电阻	$R_G$	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 0V,$ Frequency=1MHZ	--	5.6	--	Ω
二极管正向电压	$V_{SD}$	$I_S = -6A, V_{GS} = 0V$	--	--	-0.99	V
	$E_{AS}$	$V_G = -10V, V_d = -30V$ $L = 0.5mH, R_g = 25\text{ohm},$ $I_D = -23A$	PASS			
	g(fs)	$V_{DS} = -5V, I_D = -6A$	10.0	--	--	S
注 1	Pulse Test : Pulse width $\leq 300\mu s$ , Duty cycle $\leq 2\%$					



#### 封装信息

#### SOP-8



符号	毫米		
	最小值	典型值	最大值
A	-	1.50	1.55
A1	-	0.10	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.55	0.60	0.65
b	0.35	0.40	0.45
c	0.17	0.22	0.25
D	4.85	4.90	4.95
E	5.90	6.00	6.10
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.60	0.65	0.70
L1	1.05BSC		
θ	0°	4°	6°